

Среди полупроводниковых приборов, используемых в цифровой и вычислительной технике, существует многочисленный класс микросхем, выполняющих функции долговременного хранения информации. Они предназначены для работы в блоках памяти ЭВМ, устройствах сбора и хранения информации, в аппаратуре автоматики и контроля для хранения констант, программ, системного программного обеспечения, результатов вычислений, промежуточных значений функций.

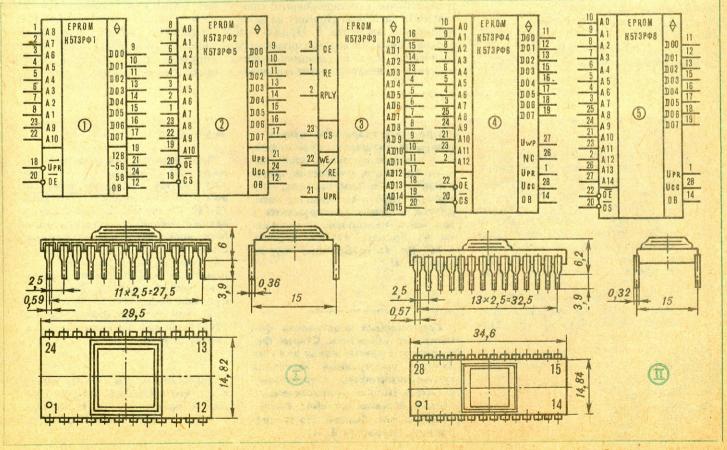
Если при отключении напряжения питания информация в запоминающем устройстве (ЗУ) не пропадает и при его восстановлении из ЗУ можно считывать ранее содержавшуюся в нем информацию, то такое ЗУ называется постоянным запоминающим устройством — ПЗУ.

По способу занесения информации ПЗУ разделяются на программируемые изготовителем (масочные ПЗУ) и на программируемые потребителем, которые, в свою очередь, подразделяются на однократно программируемые ПЗУ (ППЗУ или PROM) и на многократно перепрограммируемые ПЗУ — стираемые перепрограммируемые ПЗУ (СППЗУ или EPROM). Стирают ранее записанную информацию, облучая кристалл полупроводника ультрафиолетовым излучением через кварцевое стекло в крышке корпуса ИМС или подавая электрические импульсы.

Программирование ПЗУ производится на специальных устройствах — программаторах. На адресные входы ИМС СППЗУ подается код адреса, а на выходы — записываемая инфор-

мация, в соответствии с которыми выбираются те запоминающие элементы, которые будут подвергнуты программированию. На управляющие входы ИМС подаются электрические импульсы определенной амплитуды и длительности, которые воздействуют на запоминающий элемент и вызывают в нем физические или структурные изменения. В результате при чтении запоминающий элемент будет выдавать на выход инверсную информацию по сравнению с незапрограммированным состоянием.

Многократно перепрограммируемые СППЗУ изготавливаются на основе запоминающего элемента, представляющего собой полевой транзистор с двумя затворами, один из которых «плавающий», так как он со всех сторон окружен слоем изолятора. Инфор-



	Инфор- мацион- ная емкость	Органи- зация ПЗУ	Статические параметры					Динамические параметры				Время		et berg		
			считывание/хранение			программи- рование		считывание			про- грам- миро- вание	хранения информации:		циклов пере- про-	Кор-пус	Обо- знач.
			ток потреб- ления I <sub>cc max</sub>	напря- жение на входе U <sub>PR</sub>	ток потреб- ления I <sub>PR max</sub>	напря- жение на входе U <sub>PR</sub>	ток потреб- ления І <sub>РЯ тах</sub>	ta(a) tv(a)	t <sub>A(CS)</sub> t <sub>V(CS)</sub>	t <sub>A(OE)</sub>	время записи инфор- мации t <sub>PW</sub>	во вклю- ченном состоя- нии	В ВЫ- КЛЮ- ЧЕННОМ СОСТОЯ- НИИ	грам- миро- вания		
and the light	бит	слов× × разрядов	мА	В	мА	В	мА	нс	нс	нс	мс / слово	тыс. час.	тыс.	¥2.		
К573РФ1	8192	1024×8	l <sub>cc1</sub> 70 l <sub>cc2</sub> 40 l <sub>cc3</sub> 15	0	3	26±1	20	450	_	120	300	20	100	100	I to	1
К573РФ2	16384	2048×8	100 35	5±0,25	10 2	25±0,5	30	450	450	200	50±5	25	100	100	(e)	2
К573РФ3	65536	4096×16	85 40	5±0,25	-	18±1,8	40	-	-	400	50±5	15	15	10	1	3
К573РФ4	65536	8192×8	60 10	5±0,25	<u>6</u> 5	21±0,5	50	A 300 E 450	300 450	150 150	50±5	25	100	25	11	4
К573РФ5	16384	2048×8	100 25	5±0,25	10	25±0,5	30	450	450	200	50±5	50	100	100	1.00	2
К573РФ6	65536	8192×8	100 40	5±0,25	5 5	21 ± 0,5	30	A 300 E 450	300 450	150 150	50±5	20	40	25	H	4
К573РФ8	262144	32768×8	100 25	5±0,25	5 5	18±0,5	50	350	350	150	50±5	25	25	25	0.	5

 $0 \text{ B} \leqslant \text{U}_{iL} \leqslant 0,4 \text{ B} - \text{входное напряжение лог. 0,} 2,4 \text{ B} \leqslant \text{U}_{iH} \leqslant 6 \text{ B} - \text{входное напряжение лог. 1,} I_{iH} \geqslant 10 \text{ мкА} - \text{входной ток лог. 0,} I_{iL} \leqslant 10 \text{ мкА} - \text{входной ток лог. 0,} I_{iL} \leqslant 10 \text{ мкА} - \text{входной ток лог. 0,} I_{iL} \leqslant 10 \text{ мкА} - \text{выходное напряжение лог. 0,} I_{iL} \leqslant 1,6 \text{ MA} - \text{выходное напряжение лог. 1,} I_{oL} \leqslant 1,6 \text{ мA} - \text{выходной ток лог. 0,} I_{iH} \geqslant 0,1 \text{ мA} - \text{выходной ток лог. 1,} I_{occ} = 5 \pm 0,25 \text{ B} - \text{напряжения питания.} I_{occ} = 5 \pm 0,25 \text{ B} + \text{напряжения питания.} I_{occ} = 5 \pm 0,25 \text{ B} + \text{напряжения питания.} I_{occ} = 5 \pm 0,25 \text{ B} + \text{напряжения} I_{occ} = 12 \pm 1,2 \text{ B};} I_{occ} = -5 \pm 0,25 \text{ B} + \text{напряжения} I_{occ} = 12 \pm 1,2 \text{ B};} I_{occ} = -5 \pm 0,25 \text{ B} + \text{напряжения} I_{occ} = 12 \pm 1,2 \text{ B};} I_{occ} = -5 \pm 0,25 \text{ B} + \text{напряжения} I_{occ} = 12 \pm 1,2 \text{ B};} I_{occ} = -5 \pm 0,25 \text{ B} + \text{напряжения} I_{occ} = 12 \pm 1,2 \text{ B};} I_{occ} = -5 \pm 0,25 \text{ B} + \text{напряжения} I_{occ} = 12 \pm 1,2 \text{ B};} I_{occ} = -5 \pm 0,25 \text{ B} + \text{напряжения} I_{occ} = 12 \pm 1,2 \text{ B};} I_{occ} = -5 \pm 0,25 \text{ B} + \text{напряжения} I_{occ} = 12 \pm 1,2 \text{ B};} I_{occ} = -5 \pm 0,25 \text{ B} + \text{напряжения} I_{occ} = 12 \pm 1,2 \text{ B};} I_{occ} = -5 \pm 0,25 \text{ B} + \text{напряжения} I_{occ} = 12 \pm 1,2 \text{ B};}$ 

Диапазон рабочих температур: -10...+70° С.

мация хранится в «плавающем» затворе в виде зарядов электронов, которые инжектируются в него при программировании. Транзистор, у которого «плавающий» затвор заряжен, обладает повышенным пороговым напряжением отпирания по сравнению с транзистором с незаряженным «плавающим» затвором. Поэтому из запоминающего элемента с заряженным «плавающим» затвором считывается логический 0, а из запоминающего элемента с незаряженным «плаваю-

щим» затвором считывается логическая 1. Заряд на «плавающем» затворе и, следовательно, информация в СППЗУ может храниться более 10 лет.

Управление работой ИМС СППЗУ осуществляется подачей сигналов на входы адреса — A, «выбор кристалла» — CS или «разрешение выходов» — ОЕ (OUTPUT ENABL).

Основные данные стираемых ультрафиолетовым излучением программируемых микросхем ПЗУ (СППЗУ) приведены в таблице.

## куплю

Старые книги, альбомы, журналы по истории морского флота, авиации, архитектуры, русской истории, философии, живописи, геральдике; энциклопедии и энциклопедические словари. Почтовые марки и открытки, каталоги медалей, монет и др. предметов старины. 129075, Москва, И-75. До востребования Васильеву С. И.

Неновый автомобиль любой марки. 119435, Москва. До востребования, Шухову В. Ф. Тел. 215-24-36.



Предметы старинной техники — пишущую машинку, граммофон, музыкальную шкатулку, колокольчики, барометр, микроскоп, фотоаппарат, объективы, бинокль, подзорную трубу, светильник, часы, другие приборы и инструменты (в том числе неисправные), предметы из броизы. 129075, Москва, И-75. До востребования, Журавлеву М. И.

Современный иностранный фотоаппарат, объективы. Старые фотоаппараты разных марок для коллекции. Иностранный кассетный стереомагнитофон, стереопроигрыватель (можно — неисправные). 140150, Московская обл., Раменский р-и, пос. Быково. До востребования, муратову В. И.

## MEHAIO

Японскую зеркальную фотокамеру ТТЛ «Олимпус ОМ-1Н» (подержанную) с новыми объективом-трансфокатором «Зуйко» 75-150/4 и фотовспышкой с двумя автоматическими программами (вед. число 24) — на фотокамеру, объективы систем «Пентакс», «Канон», «Никон», «Лейка» и им подобные или на широкоформатную фотоаппаратуру (иностранную или новый «Киев-88» с оптикой), панорамные фотоаппараты. 129515, Москва. До востребования, Гукову В. В. Тел. 285-88-67.

Напоминаем (см. «М-К» № 10 с. г.), что прием объявлений временно прекращен (с 1 декабря с. г.). О возобновлении объявим дополнительно.